

硅 PNP 外延平面功率晶体管芯片

■用途

* 中等功率放大器

* 中速开关应用

■极限值 (Ta=25°C)

参数名称	符号	额定值	单位
最大集电极电流	I_{CM}	-1.5	A
耗散功率	P_{tot}	1	W
结温	T_j	150	°C
贮存温度	T_{stg}	-55~150	°C

■电参数 (Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C = -0.1 \text{ mA}, I_E = 0$	-120		V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C = -1 \text{ mA}, I_B = 0$	-100		V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E = -0.1 \text{ mA}, I_C = 0$	-6		V
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = -96V, I_E = 0$		-0.5	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$		-0.5	μA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	100	300	
集电极-发射极饱和电压	V_{CES}	$I_C = -1A, I_B = -0.1A$		-0.6	V
基极-发射极饱和电压	V_{BES}	$I_C = -1A, I_B = -0.1A$		-1.5	V